

Information

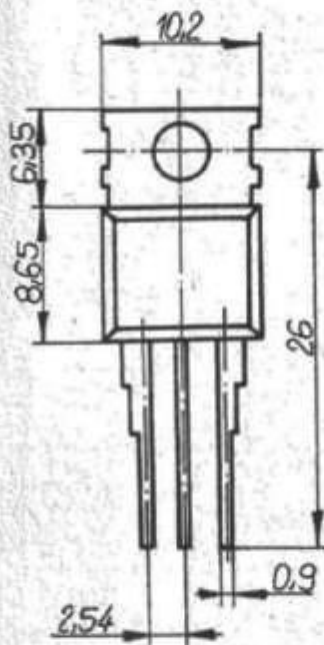


SU 378 / SU 380

1/85

Hersteller: VEB Mikroelektronik „Karl Liebknecht“ Stahnsdorf

Si-npn-Leistungsschalttransistor für Schaltnetzteile



Masse ca. 2,5 g

Kollektor am Gehäuse

TO 220

Bild 1: Maße in mm und Anschlußbelegung

Grenzwerte, gültig für den Umgebungstemperaturbereich $T_a = -25^{\circ}\text{C} \dots +100^{\circ}\text{C}$

		SU 378	SU 380
Kollektor-Basis-Spannung $I_E = 0$	U_{CB0}	700	850 V
Kollektor-Emitter-Spannung $I_B = 0$	U_{CE0}	400	V
Kollektorstrom	I_C	6	A
Kollektorspitzenstrom	I_{CM}	8	A
Gesamtverlustleistung $t \leq 25^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	85	W
Sperrschichttemperatur	t_j	175	$^{\circ}\text{C}$
Betriebstemperatur	t_a	125	$^{\circ}\text{C}$
<u>Kennwerte, bei $t_C = 25^{\circ}\text{C} - 5\text{K}$</u>			
		min	max
Kollektor-Emitter-Reststrom $U_{CE} = -2\text{V}, U_{CE} = U_{CB0}$	I_{CEX}		0,3 mA
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung $I_C = 2,5\text{A}, I_B = 0,5\text{A}$	U_{CEsat}		1,5 V
Basis-Emitter-Sättigungsspannung $I_C = 2,5\text{A}, I_B = 0,5\text{A}$	U_{BEsat}		1,3 V
Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung $I_C = 0,2\text{A}$	$U_{(BR)CEO} \approx 450\text{V}$ $\approx 400\text{V}$		SU 378 SU 380
Emitter-Basis-Durchbruchsspannung $I_E = 0,01\text{A}$	$U_{(BR)EB0} \approx 7\text{V}$		
Abfallzeit des Kollektorstromes $I_C = 2,5\text{A}, I_B = 0,5\text{A}, -I_B = 1\text{A}$ $U_{CC} = 150\text{V}$	t_f	$\leq 0,8$	μs

Bestellbezeichnung: Transistor SU 378
Transistor SU 380

Änderungen vorbehalten!

Die vorliegenden Datenblätter dienen ausschließlich der Information! Es können daraus keine Liefermöglichkeiten oder Produktionsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten.

RFT

Herausgeber:

veb applikationszentrum elektronik berlin
im veb kombinat mikroelektronik

DDR-1035 Berlin, Mainzer Straße 25

Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981; 011 3055